

Final datasheet

EasyPACK™ Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET und Hochstrom-Pin / NTC

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{DS} = 2000\text{ V}$
 - $I_{DN} = 400\text{ A}$ / $I_{DRM} = 640\text{ A}$
 - Niedrige Schaltverluste
 - Hohe Stromdichte
 - Geeignete Infineon Gate-Treiber finden Sie unter <https://www.infineon.com/gdfinder>
- Mechanische Eigenschaften
 - 3,2 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
 - Hochstrom-Pin
 - PressFIT Verbindungstechnik
 - Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern
 - Integrierter NTC Temperatur Sensor



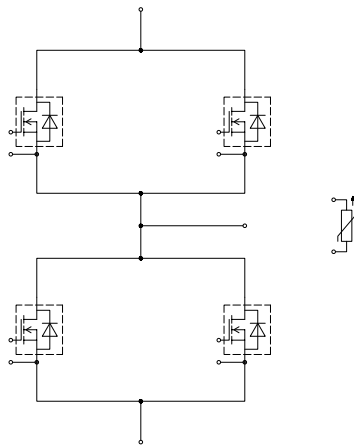
Potenzielle Anwendungen

- Energiespeichersysteme
- EV-Laden
- USV-Systeme
- Solar Anwendungen

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2	3
3	Body diode (MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2)	5
4	NTC-Widerstand	6
5	Kennlinien	7
6	Schaltplan	14
7	Gehäuseabmessungen	15
8	Modul-Label-Code	16
	Änderungshistorie	17
	Disclaimer	18

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.2	kV
Isolationsprüfspannung NTC	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.2	kV
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 400	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	RTI	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}			17		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, pro Schalter		1		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	1.3		1.5	Nm
Gewicht	G			78		g

Anmerkung: The current under continuous operation is limited to 50A rms per high current pin.

2 MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Drain-Source-Spannung	V_{DSS}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	2000	V
Implementierter Drain-Strom	I_{DN}		400	A
Drain-Dauergleichstrom	I_{DDC}	$T_{vj} = 175 \text{ °C}$, $V_{GS} = 18 \text{ V}$ $T_H = 65 \text{ °C}$	275	A
Periodischer Drain-Spitzenstrom	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}	640	A
Gate-source Spannung, max. transiente Spannung	V_{GS}	$D < 0.01$	-10/23	V
Gate-source Spannung, max. statische Spannung	V_{GS}		-7/20	V

Tabelle 4 Empfohlene Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Ein-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Aus-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

Tabelle 5 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	$I_D = 320\text{ A}$	$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		2.6	4.1	mΩ
			$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 125\text{ °C}$		5.4		
			$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 175\text{ °C}$		7.7		
			$V_{GS} = 15\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		2.8		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	$I_D = 224\text{ mA}, V_{DS} = V_{GS}, (\text{tested after 1ms pulse at } V_{GS} = +20\text{ V}), T_{vj} = 25\text{ °C}$		3.45	4.3	5.15	V
Gateladung	Q_G	$V_{DD} = 1200\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			1.56		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			0.9		Ω
Eingangskapazität	C_{ISS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 1500\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		47.9		nF
Ausgangskapazität	C_{OSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 1500\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		1.12		nF
Rückwirkungskapazität	C_{rss}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 1500\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.084		nF
C_{OSS} Speicherenergie	E_{OSS}	$V_{DS} = 1500\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			1470		μJ
Drain-Source-Reststrom	I_{DSS}	$V_{DS} = 2000\text{ V}, V_{GS} = -3\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.08	660	μA
Gate-Source-Reststrom	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	$V_{GS} = 20\text{ V}$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\ on}$	$I_D = 320\text{ A}, R_{Gon} = 3\text{ }\Omega, V_{DD} = 1500\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, t_{dead} = 1000\text{ ns}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		86		ns
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		82		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		81		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_D = 320\text{ A}, R_{Gon} = 3\text{ }\Omega, V_{DD} = 1500\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, t_{dead} = 1000\text{ ns}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		44		ns
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		39		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		39		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 5 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\ off}$	$I_D = 320\ A, R_{Goff} = 1\ \Omega,$ $V_{DD} = 1500\ V,$ $V_{GS} = -3/18\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	123		ns
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	136		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	142		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_D = 320\ A, R_{Goff} = 1\ \Omega,$ $V_{DD} = 1500\ V,$ $V_{GS} = -3/18\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	62		ns
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	65		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	67		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_D = 320\ A, V_{DD} = 1500\ V,$ $L_\sigma = 8\ nH, V_{GS} = -3/18\ V,$ $R_{Gon} = 3\ \Omega, di/dt = 9$ $kA/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C),$ $t_{dead} = 1000\ ns$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	44.3		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	49.7		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	56.5		
Einschaltverlustenergie pro Puls, optimiert	$E_{on,o}$	$I_D = 320\ A, V_{DD} = 1500\ V,$ $L_\sigma = 8\ nH, V_{GS} = -3/18\ V,$ $R_{Gon,o} = 1\ \Omega, di/dt =$ $17\ kA/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C),$ $t_{dead} = 100\ ns$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	22.2		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	23.7		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	26.6		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_D = 320\ A, V_{DD} = 1500\ V,$ $L_\sigma = 8\ nH, V_{GS} = -3/18\ V,$ $R_{Goff} = 1\ \Omega, dv/dt = 26.6$ $kV/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	12		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	13.5		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	14		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro MOSFET, $\lambda_{grease} = 3.3\ W/(m \cdot K)$		0.12		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		175	$^\circ C$

Anmerkung: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN 2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.
 $T_{vj\ op} > 150\ ^\circ C$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

3 Body diode (MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2)

Tabelle 6 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Body Diode-Gleichstrom	I_{SD}	$T_{vj} = 175\ ^\circ C, V_{GS} = -3\ V$ $T_H = 65\ ^\circ C$	210	A

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_{SD}	$I_{SD} = 320 \text{ A}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	4.4	5.95	V
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	4		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	3.85		
Rückstromspitze	I_{rrm}	$I_{SD} = 320 \text{ A}$, $di_s/dt = 9 \text{ kA}/\mu\text{s}$, $V_{DD} = 1500 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	156		A
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	229		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	292		
Sperrverzögerungsladung	Q_{rr}	$I_{SD} = 320 \text{ A}$, $di_s/dt = 9 \text{ kA}/\mu\text{s}$, $V_{DD} = 1500 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	9.2		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	14.8		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	19.7		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$I_{SD} = 320 \text{ A}$, $di_s/dt = 9 \text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ °C}$), $V_{DD} = 1500 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	8.1		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	10.2		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	11.9		
Abschaltenergie pro Puls, optimiert	$E_{rec,o}$	$I_{SD} = 320 \text{ A}$, $di_s/dt = 17 \text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ °C}$), $V_{DD} = 1500 \text{ V}$, $V_{GS} = -3 \text{ V}$, $t_{dead} = 100 \text{ ns}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	10.8		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	12.5		
			$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	13		

4 NTC-Widerstand

Tabelle 8 Charakteristische Werte

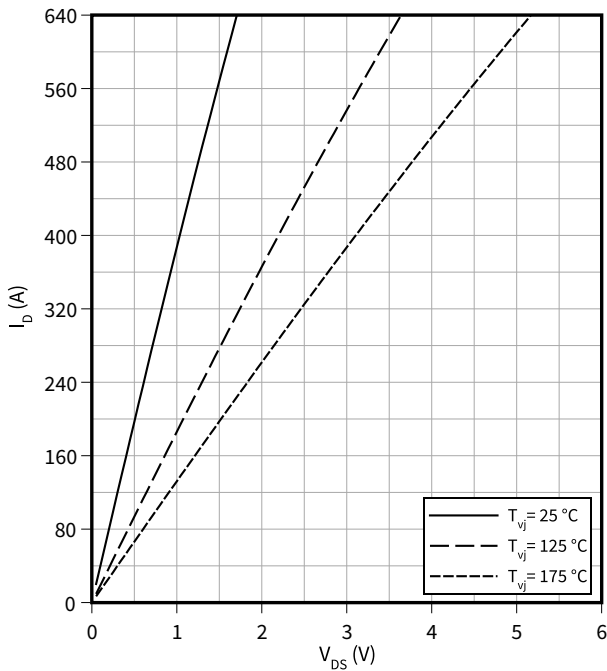
Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$		5		k Ω
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ °C}$, $R_{100} = 493 \text{ }\Omega$	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ °C}$			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K

Anmerkung: Eine detaillierte Beschreibung der NTC-Eigenschaften finden Sie in der AN2009-10, Kapitel 4

5 Kennlinien

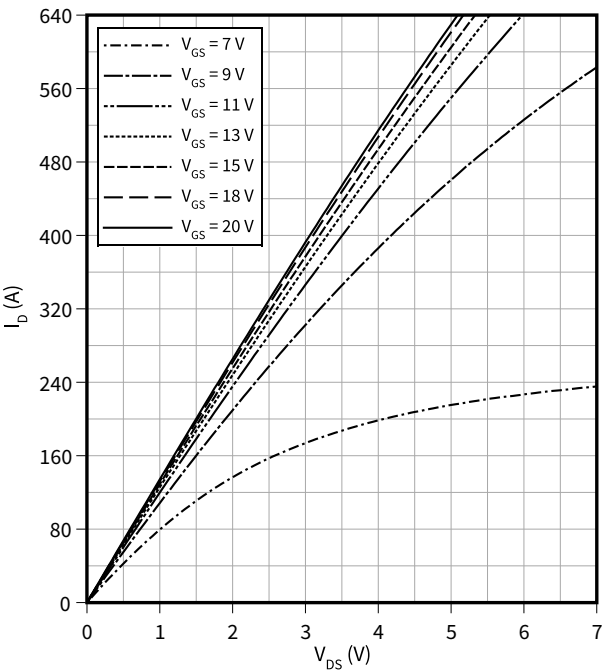
Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$I_D = f(V_{DS})$
 $V_{GS} = 18\text{ V}$



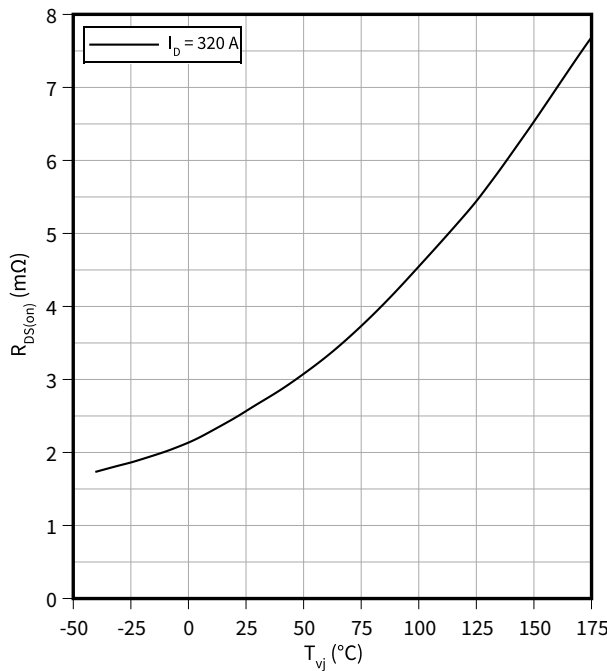
Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$I_D = f(V_{DS})$
 $T_{vj} = 175\text{ °C}$



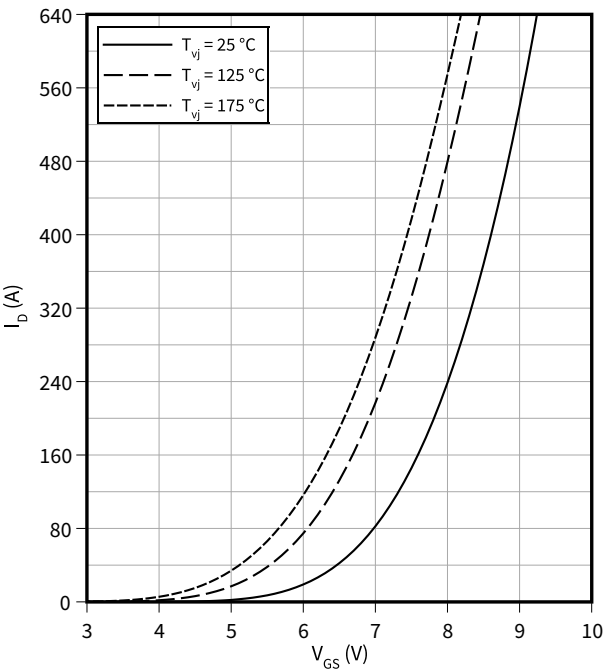
Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$
 $V_{GS} = 18\text{ V}$



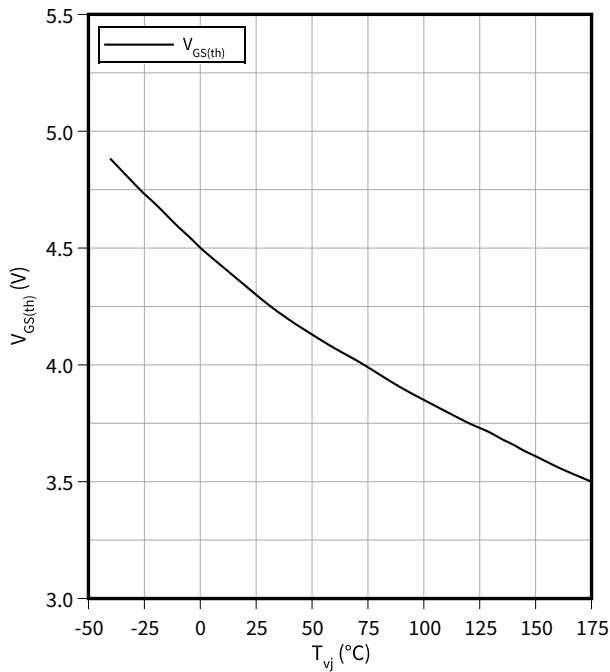
Übertragungscharakteristik (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$I_D = f(V_{GS})$
 $V_{DS} = 20\text{ V}$



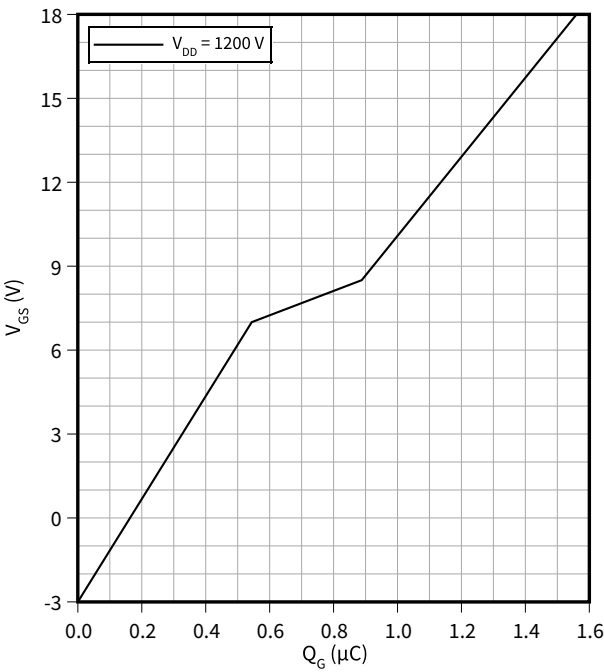
Gate-Source Schwellspannung (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
 $I_D = 224\text{ mA}$, $V_{GS} = V_{DS}$



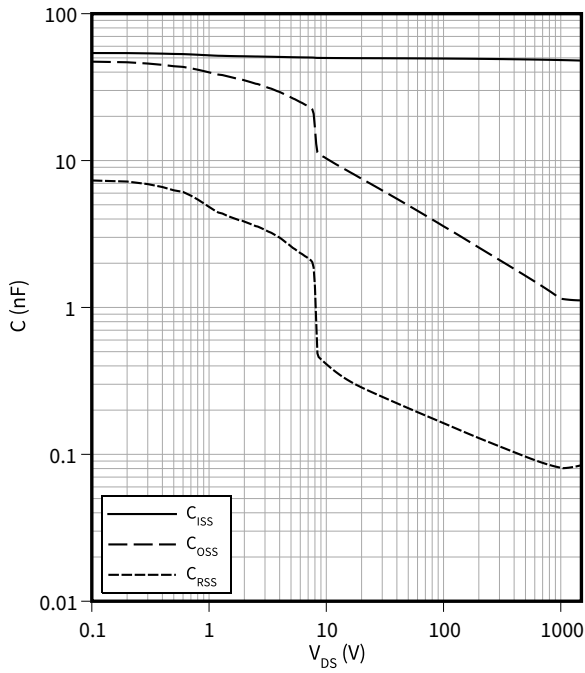
Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$V_{GS} = f(Q_G)$
 $I_D = 320\text{ A}$, $T_{vj} = 25\text{ °C}$



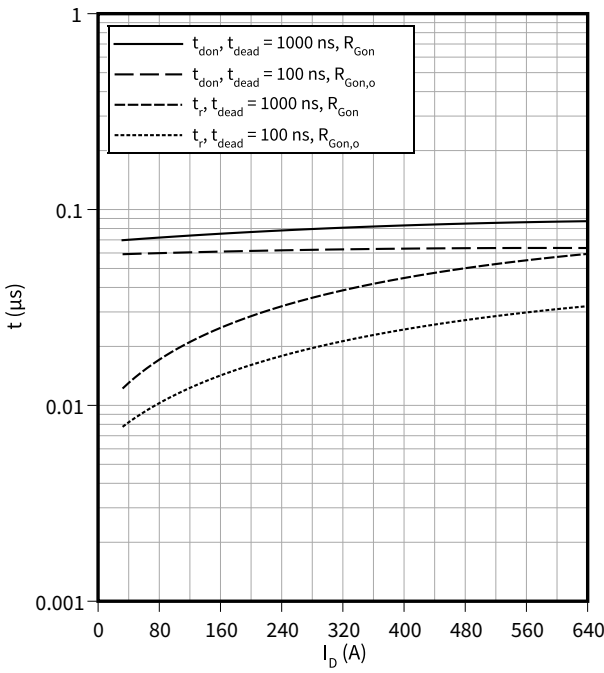
Kapazitäts Charakteristik (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$C = f(V_{DS})$
 $f = 100\text{ kHz}$, $T_{vj} = 25\text{ °C}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

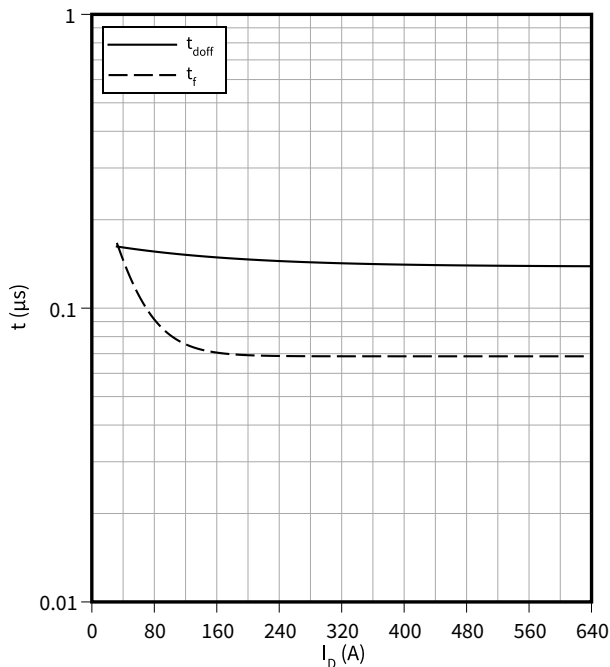
$t = f(I_D)$
 $V_{DD} = 1500\text{ V}$, $R_{Gon} = 3\text{ }\Omega$, $R_{Gon,o} = 1\text{ }\Omega$, $T_{vj} = 175\text{ °C}$, $V_{GS} = -3/18\text{ V}$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$t = f(I_D)$

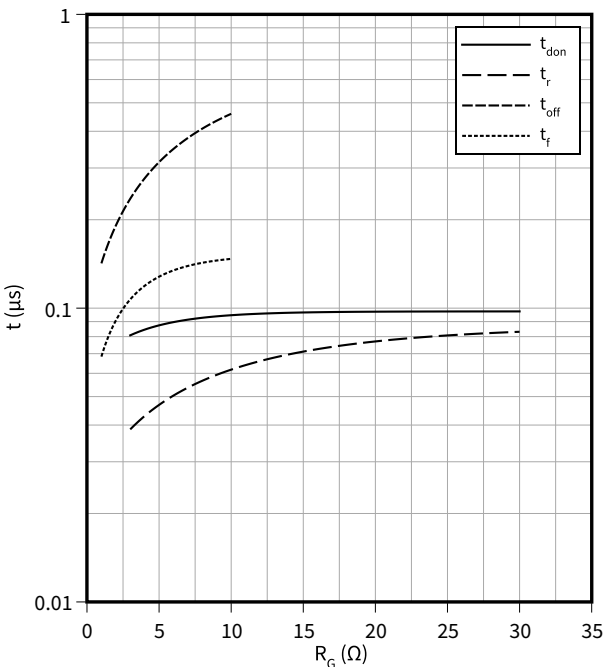
$R_{Goff} = 1 \Omega$, $V_{DD} = 1500 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$t = f(R_G)$

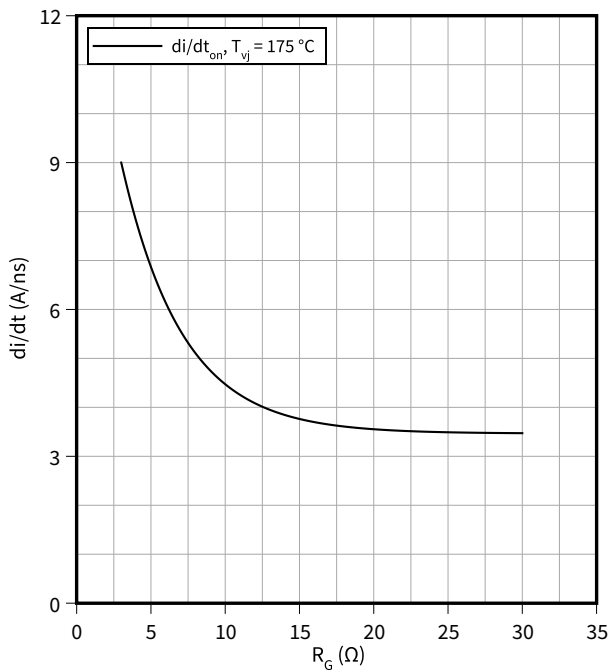
$V_{DD} = 1500 \text{ V}$, $t_{dead} = 1000 \text{ ns}$, $I_D = 320 \text{ A}$, $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Stromsteilheit (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$di/dt = f(R_G)$

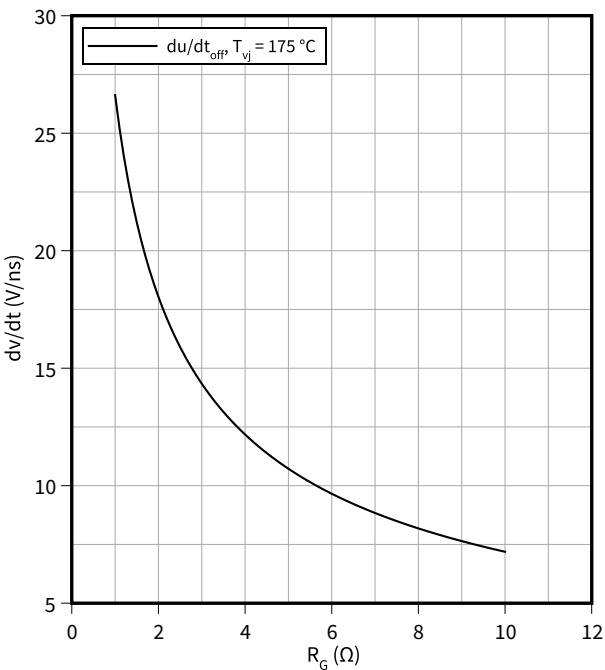
$V_{DD} = 1500 \text{ V}$, $I_D = 320 \text{ A}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Spannungssteilheit (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

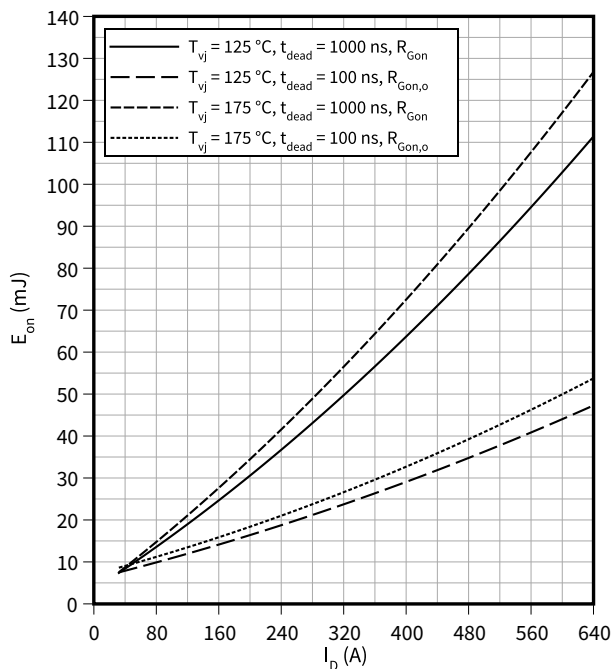
$dv/dt = f(R_G)$

$V_{DD} = 1500 \text{ V}$, $I_D = 320 \text{ A}$, $V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



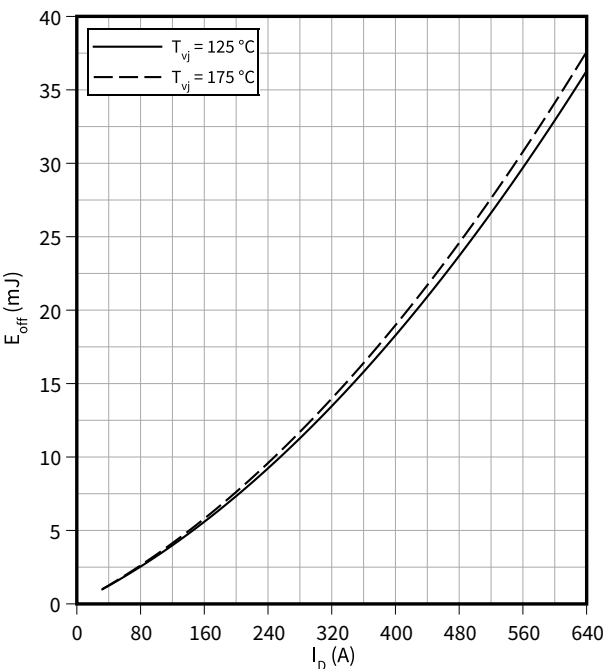
Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$E_{on} = f(I_D)$
 $V_{DD} = 1500\text{ V}, R_{Gon} = 3\ \Omega, R_{Gon,o} = 1\ \Omega, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



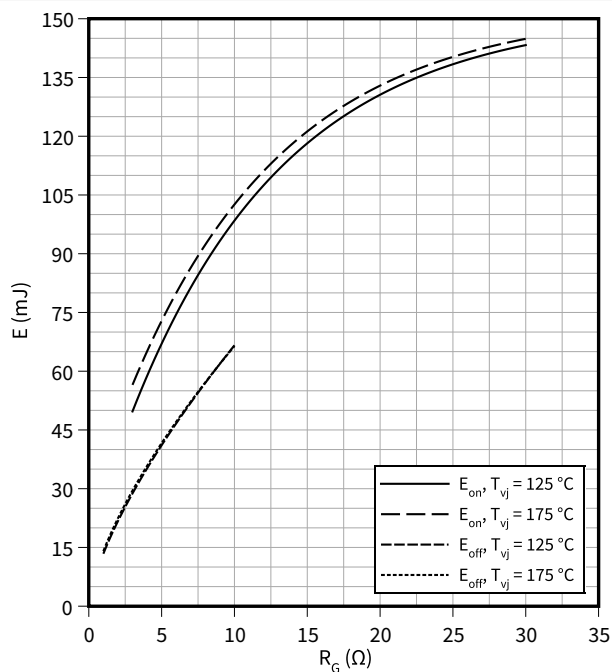
Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$E_{off} = f(I_D)$
 $R_{Goff} = 1\ \Omega, V_{DD} = 1500\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



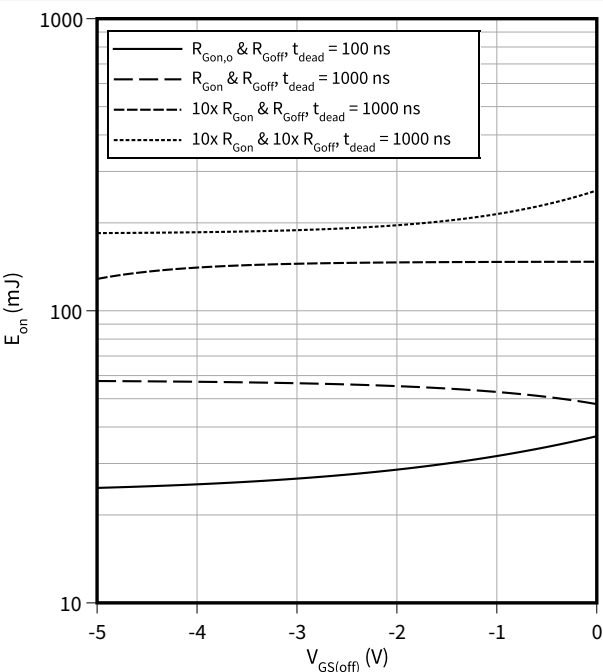
Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$E = f(R_G)$
 $V_{DD} = 1500\text{ V}, t_{dead} = 1000\text{ ns}, I_D = 320\text{ A}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



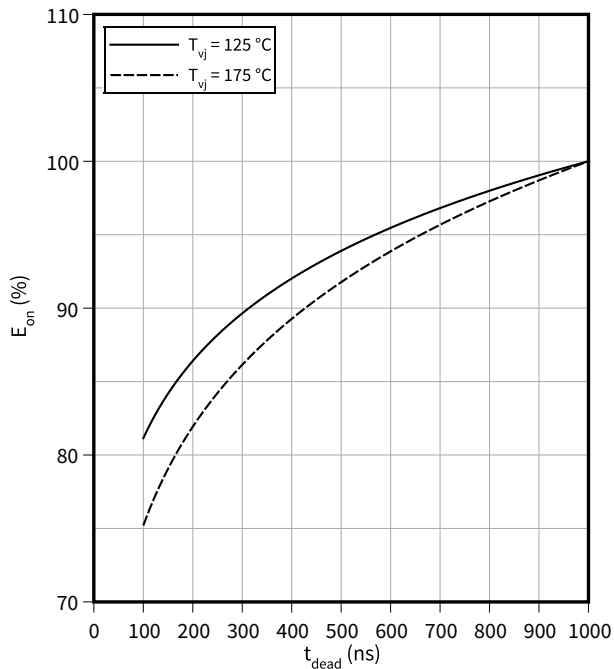
Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$E_{on} = f(V_{GS(off)})$
 $R_{Goff} = 1\ \Omega, V_{DD} = 1500\text{ V}, R_{Gon} = 3\ \Omega, V_{GS(on)} = 18\text{ V}, I_D = 320\text{ A}, R_{Gon,o} = 1\ \Omega, T_{vj} = 175\text{ °C}$



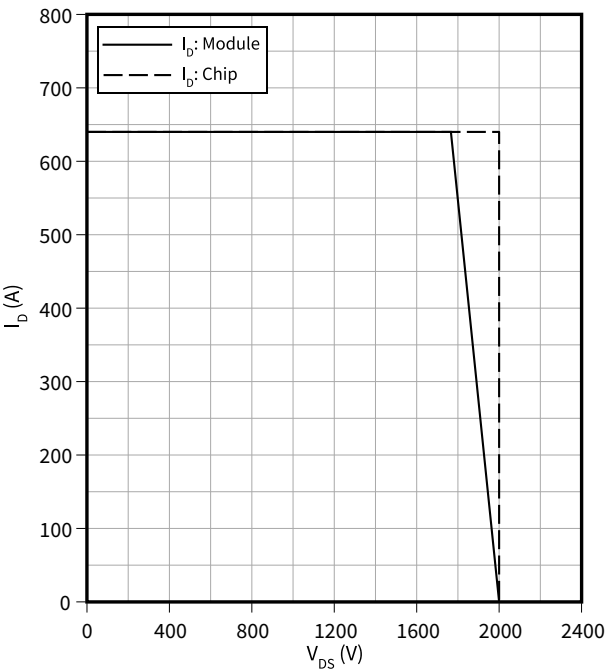
Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$E_{on} = f(t_{dead})$
 $R_{Gon} = 3 \Omega, I_D = 320 \text{ A}, V_{DD} = 1500 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



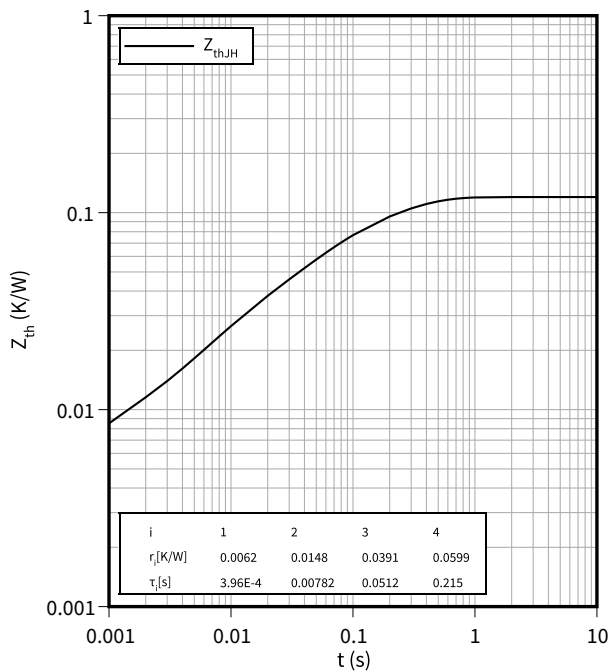
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$I_D = f(V_{DS})$
 $R_{Goff} = 1 \Omega, T_{vj} = 175 \text{ °C}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



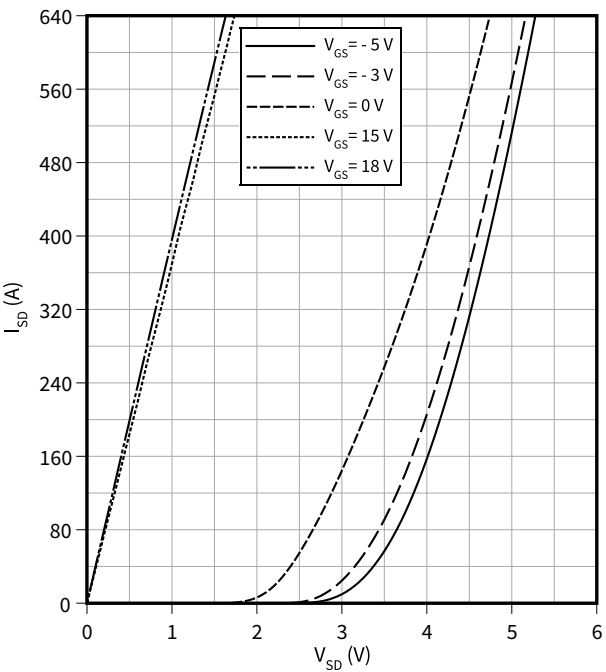
Transienter Wärmewiderstand, MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$Z_{th} = f(t)$



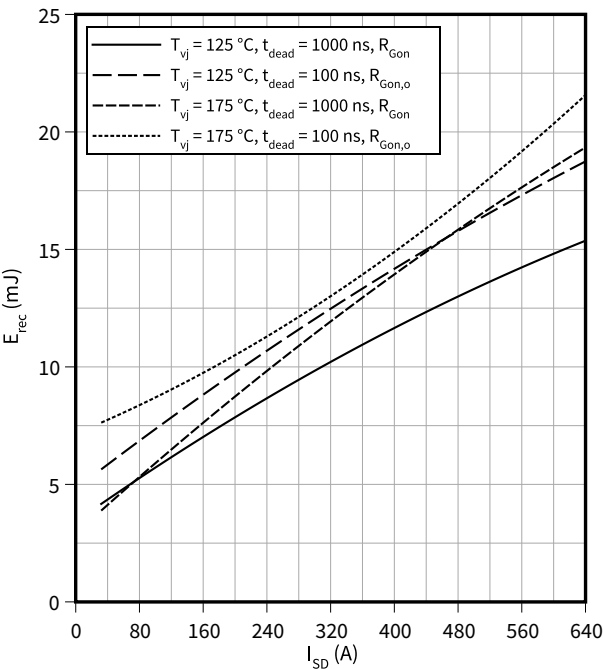
Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$I_{SD} = f(V_{SD})$
 $T_{vj} = 25 \text{ °C}$



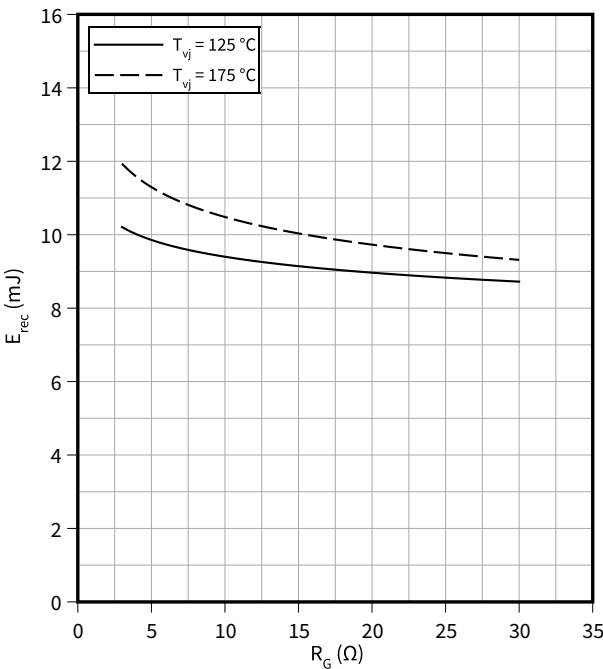
Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$E_{rec} = f(I_{SD})$
 $R_{Gon} = 3\ \Omega$, $R_{Gon,o} = 1\ \Omega$, $V_{DD} = 1500\ V$



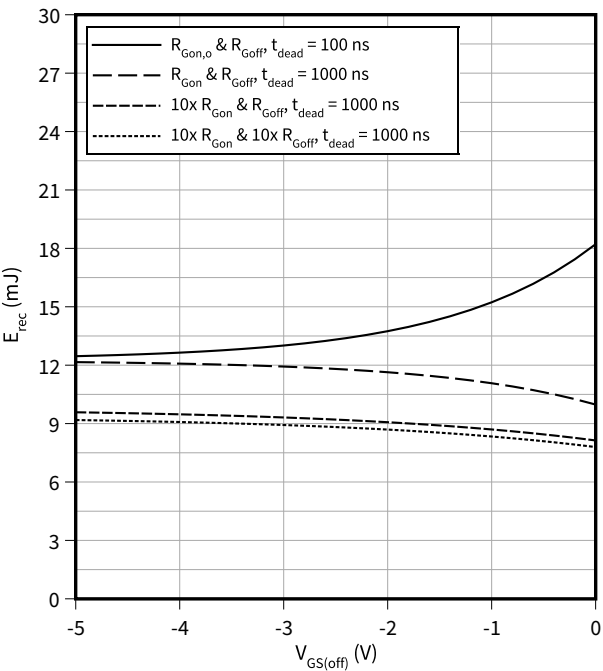
Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$E_{rec} = f(R_G)$
 $t_{dead} = 1000\ ns$, $I_{SD} = 320\ A$, $V_{DD} = 1500\ V$



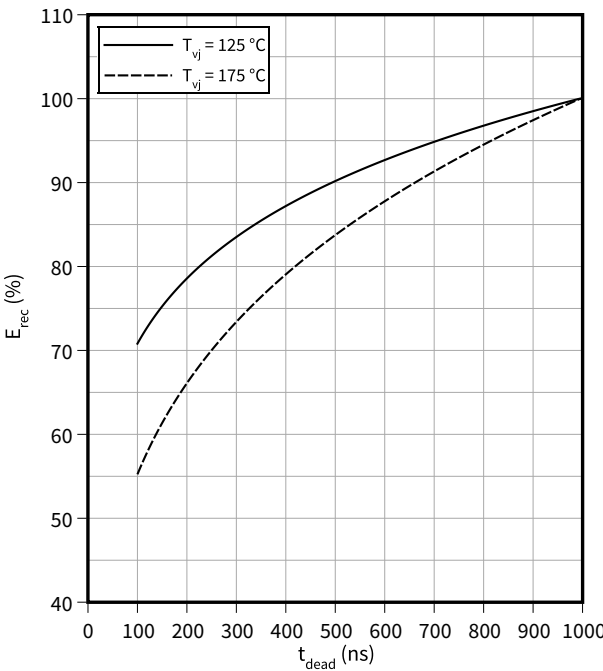
Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$E_{rec} = f(V_{GS(off)})$
 $R_{Goff} = 1\ \Omega$, $R_{Gon} = 3\ \Omega$, $V_{GS(on)} = 18\ V$, $I_{SD} = 320\ A$, $R_{Gon,o} = 1\ \Omega$, $V_{DD} = 1500\ V$, $T_{vj} = 175\ ^\circ C$



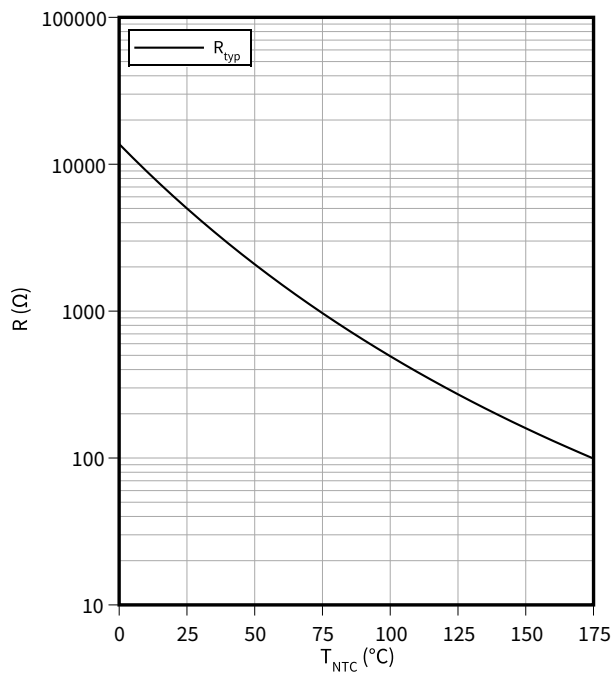
Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

$E_{rec} = f(t_{dead})$
 $R_{Gon} = 3\ \Omega$, $I_D = 320\ A$, $V_{DD} = 1500\ V$, $V_{GS} = -3/18\ V$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



6 Schaltplan

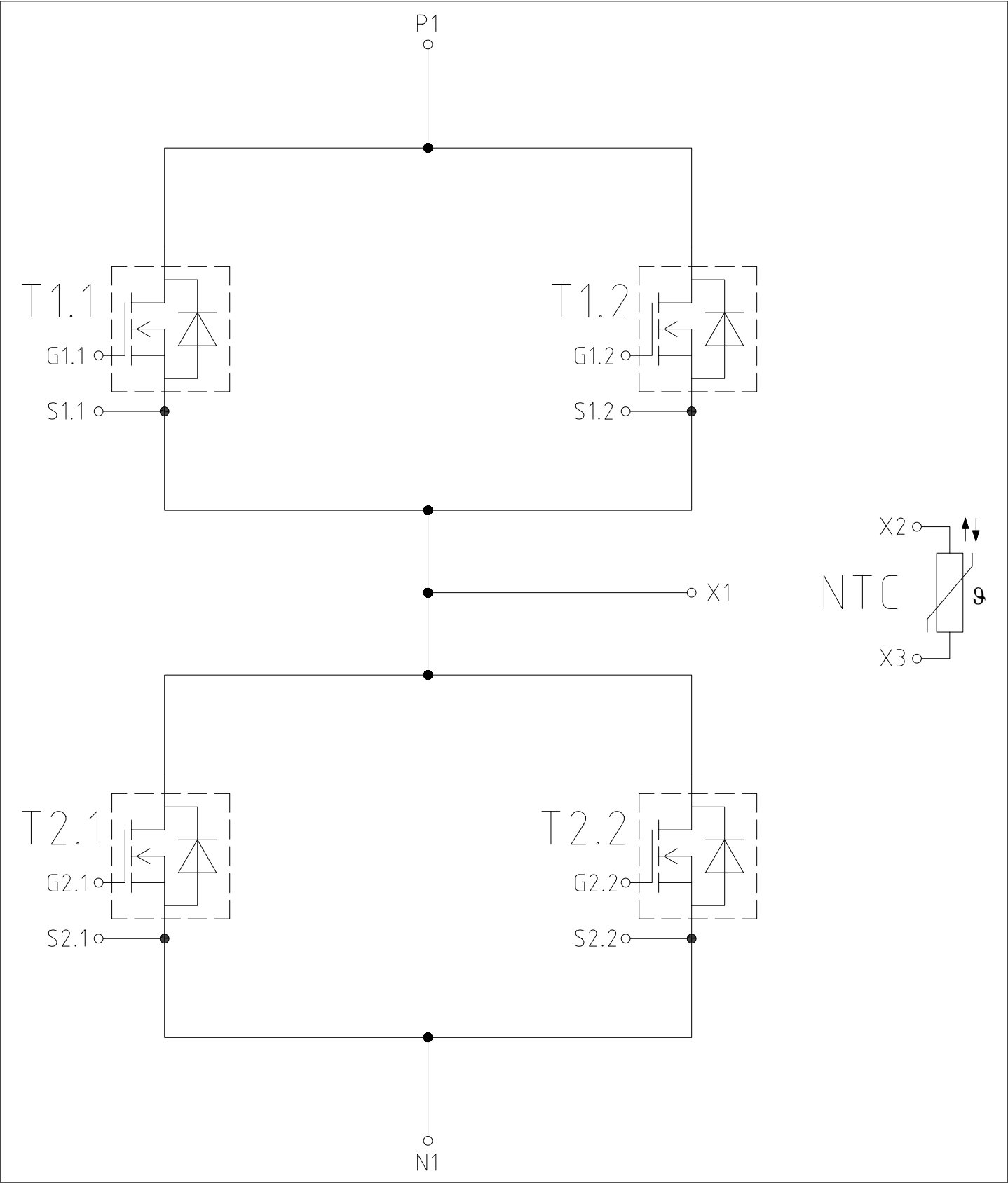


Abbildung 1

7 Gehäuseabmessungen

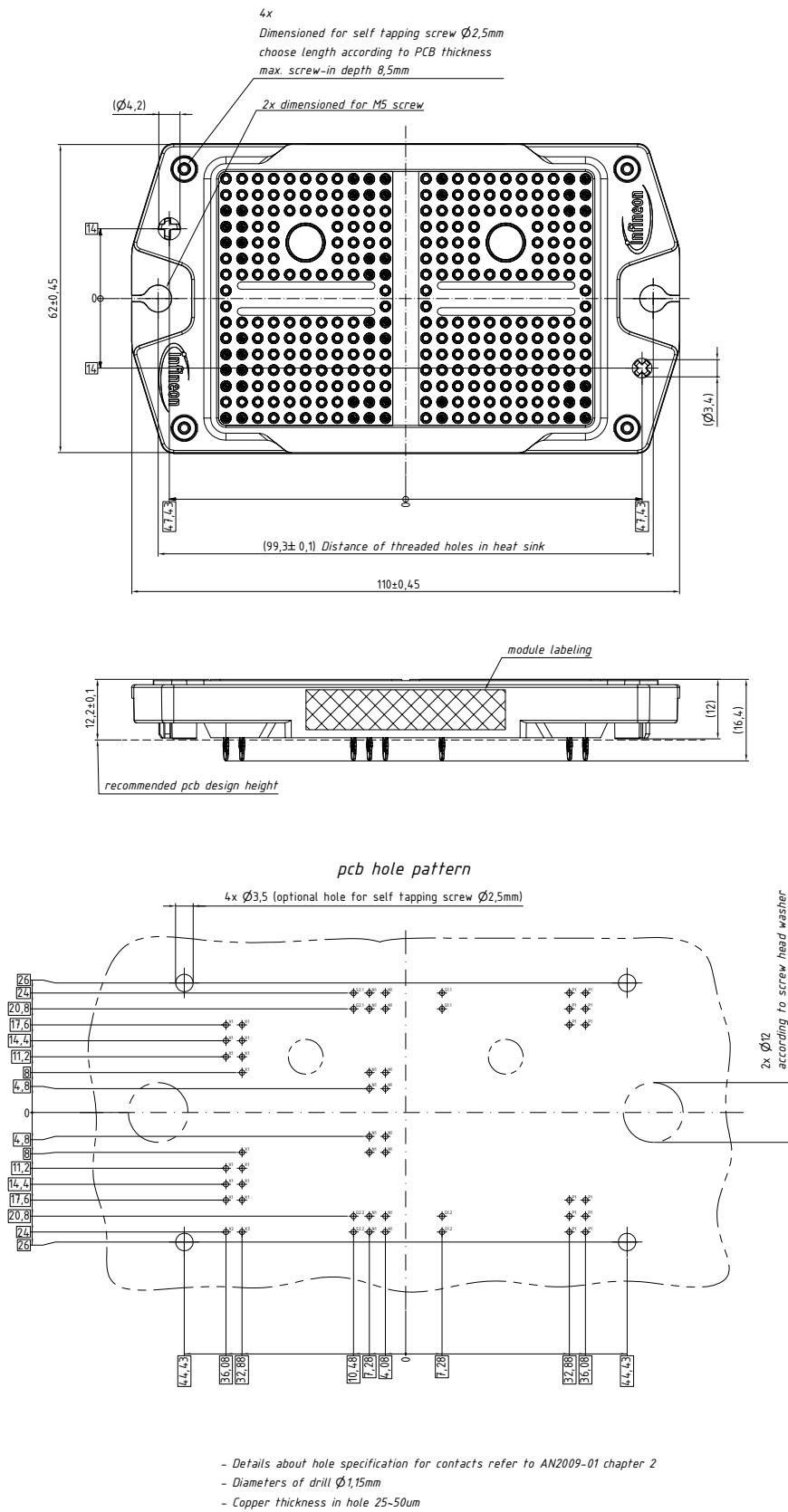


Abbildung 2

8 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example			
	 7154914284655054991153071549142846550549911530		

Abbildung 3



Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung
0.10	2024-02-12	Initial version
1.00	2025-01-13	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-01-13

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABJ480-002

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.